

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. сток-исток, В	Макс. ток сток-исток, А	Макс. напр. затвор-исток, В	Сопр. канала в откр. сост., МОм	Макс. рассеиваемая мощность, Вт	Крутизна хар-ки, мА/В	Тип корпуса
2П 103 АР	P-FET	10	-	2.2	-	0.12	1	КТ-17
КП 103 А	N-FET	10	-	2.2	-	0.12	1	КТ-17
2П 103 Б	P-FET	10	-	3	-	0.12	2	КТ-17
2П 103 В	P-FET	10	-	4	-	0.12	3	КТ-17
2П 103 Г ОС	P-FET	10	-	6	-	0.12	3	КТ-17
2П 103 Г	P-FET	10	-	6	-	0.12	3	КТ-17
2П 103 Д	P-FET	10	-	7	-	0.12	3	КТ-17
КП 103 Е	P-FET	10	-	1.5	-	0.007	1	-
КП 103 Е1	P-FET	10	-	1.5	-	0.007	1	КТ-26
КП 103 ЕР	P-FET	10	-	1.5	-	0.007	1	-
КП 103 Ж	P-FET	10	-	2.2	-	0.012	2	-
КП 103 Ж1	P-FET	10	-	2.2	-	0.012	2	КТ-26
КП 103 ЖР	P-FET	10	-	2.2	-	0.012	2	-
КП 103 И	P-FET	12	-	3	-	0.021	2	-
КП 103 И1	P-FET	12	-	3	-	0.021	2	КТ-26
КП 103 К	P-FET	10	-	4	-	0.038	2	-
КП 103 К1	P-FET	10	-	4	-	0.038	2	КТ-26
КП 103 Л	P-FET	12	-	6	-	0.066	3	-
КП 103 Л1	P-FET	12	-	6	-	0.066	3	КТ-26
КП 103 ЛР	P-FET	12	-	6	-	0.066	3	-
КП 103 Л1Р	P-FET	12	-	6	-	0.066	3	КТ-26
КП 103 М	P-FET	10	-	7	-	0.12	3	-
КП 103 МР	P-FET	10	-	7	-	0.12	3	-
2ПС 104 А	N-FET	25	-	1	-	0.045	1	-
КПС 104 А	N-FET	25	-	1	-	0.045	1	-
2ПС 104 Б	N-FET	25	-	1	-	0.045	1	-
КПС 104 Б	N-FET	25	-	1	-	0.045	1	-
КПС 104 В	N-FET	25	-	2	-	0.045	1	-
2ПС 104 Г	N-FET	25	-	3	-	0.045	1	-
КПС 104 Г	N-FET	25	-	3	-	0.045	1	-
2ПС 104 Д	N-FET	25	-	3	-	0.045	1	-
КПС 104 Д	N-FET	25	-	3	-	0.045	1	-
2ПС 104 Е	N-FET	25	-	2	-	0.045	1	-
КПС 104 Е	N-FET	25	-	2	-	0.045	2	-
2П 301 А	P-FET	20	-	5.4	-	0.2	2	КТ-114
2П 301 Б ОС	P-FET	20	-	5.4	-	0.2	2	КТ-114
2П 301 Б	P-FET	20	-	5.4	-	0.2	2	КТ-114
КП 301 Б	P-FET	20	15	5.4	-	0.2	2	КТ-114
2П 301 В	P-FET	20	15	5.4	-	0.2	2	КТ-114
КП 301 В	P-FET	20	15	5.4	-	0.2	2	КТ-114
КП 301 Г	P-FET	20	15	5.4	-	0.2	1	-
2П 302 А	N-FET	20	24	5	-	0.3	9	КТ-27
2П 302 А1	N-FET	20	24	5	-	0.3	9	-
2П 302 Б	N-FET	20	43	7	-	0.3	10	КТ-27
2П 302 В ОС	N-FET	20	-	10	-	0.3	-	КТ-27
2П 302 В	N-FET	20	-	10	-	0.3	-	КТ-27
КП 302 АМ	N-FET	20	24	5	-	0.3	8	ТО-18
КП 302 БМ	N-FET	20	43	7	150	0.3	10	-
КП 302 ВМ	N-FET	20	-	10	100	0.3	-	ТО-18
КП 302 ГМ	N-FET	20	-	7	150	0.3	10	-
КП 302 А1	N-FET	20	24	5	-	0.3	8	КТ-26
КП 302 Б1	N-FET	20	43	7	-	0.3	10	КТ-26
КП 302 В1	N-FET	20	-	10	-	0.3	-	КТ-26
КП 302 Г1	N-FET	20	-	7	-	0.3	11	КТ-26
2П 303 А ОС	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-112
2П 303 А	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-112
КП 303 А	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-112
КП 303 А9	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	-
2П 303 Б	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-112
КП 303 Б	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-112
2П 303 В	N-FET	25	20	4	-	0.2	3	КТ-112
КП 303 В	N-FET	25	20	4	-	0.2	3	КТ-112
КП 303 В9	N-FET	25	20	4	-	0.2	3	-
2П 303 Г	N-FET	25	20	8	-	0.2	5	КТ-112
КП 303 Г	N-FET	25	20	8	-	0.2	5	КТ-112
2П 303 Д ОС	N-FET	25	20	8	-	0.2	2.6	КТ-112
2П 303 Д	N-FET	25	20	8	-	0.2	2.6	КТ-112
КП 303 Д	N-FET	25	20	8	-	0.2	2.6	КТ-112
КП 303 Д9	N-FET	25	20	8	-	0.2	2.6	-
2П 303 Е ОС	N-FET	25	20	8	-	0.2	4	КТ-112
2П 303 Е	N-FET	25	20	8	-	0.2	4	КТ-112
КП 303 Е	N-FET	25	20	8	-	0.2	4	КТ-112
КП 303 Ж	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-112
2П 303 И	N-FET	25	20	3	-	0.2	4	КТ-112
КП 303 И	N-FET	25	20	2	-	0.2	4	КТ-112
КП 303 И	N-FET	25	20	2	-	0.2	4	КТ-112
КП 303 И9	N-FET	25	20	2	-	0.2	4	-
2П 304 А	P-FET	25	30	5	-	0.2	4	КТ-114
2П 304 А	P-FET	25	30	5	-	0.2	4	КТ-114
КП 304 А	P-FET	25	30	5	100	0.2	4	КТ-114
КП 304 А	P-FET	25	30	5	-	0.2	4	КТ-114
2П 305 А	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
2П 305 Б	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
2П 305 В	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
2П 305 Г	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
КП 305 Д	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
КП 305 Е	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
КП 305 Ж	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-112
КП 305 И	N-FET	15	15	6	-	0.15	7	КТ-112
2П 306 А	N-FET	20	20	4	-	0.15	5	КТ-112

## ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. сток-исток, В	Макс. ток сток-исток макс, А	Макс. напр. затвор-исток, В	Сопрот. канала в откр. сост., мОм	Макс. рассеив. мощность, Вт	Крутизна харак-ки, мА/В	Тип корпуса
КП 306 А	N-FET	20	20	4	-	0.15	5	КТ-112
2П 306 Б	N-FET	20	20	4	-	0.15	5	КТ-112
КП 306 Б	N-FET	20	20	4	-	0.15	5	КТ-112
2П 306 В	N-FET	20	20	6	-	0.15	5	КТ-112
КП 306 В	N-FET	20	20	6	-	0.15	5	КТ-112
2П 307 А	N-FET	25	30	3	-	0.25	6	КТ-112
КП 307 А	N-FET	25	25	3	-	0.25	6	КТ-112
КП 307 А	N-FET	25	25	3	-	0.25	6	КТ-112
2П 307 Б ОСМ	N-FET	25	30	5	-	0.25	7	КТ-112
КП 307 Б	N-FET	25	25	5	-	0.25	7	КТ-112
КП 307 В	N-FET	25	25	5	-	0.25	7	-
2П 307 Г	N-FET	25	30	6	-	0.25	9	КТ-112
КП 307 Г	N-FET	25	25	6	-	0.25	9	КТ-112
КП 307 Е	N-FET	25	25	2.5	-	0.25	5	КТ-112
КП 307 Ж	N-FET	25	25	7	-	0.25	9	КТ-112
КП 307 А1	N-FET	25	25	3	-	0.25	6	-
КП 307 Б1	N-FET	25	25	5	-	0.25	7	-
КП 307 Г1	N-FET	25	25	6	-	0.25	9	-
КП 307 Е1	N-FET	25	25	2.5	-	0.25	5	-
КП 307 Ж1	N-FET	25	25	7	-	0.25	9	-
КП 308 А-1	N-FET	25	20	1.2	-	0.06	2	-
КП 308 В-1	N-FET	25	20	2.4	-	0.06	4	-
2П 312 А	N-FET	20	25	8	-	0.10	5	КТ-23
КП 312 А	N-FET	20	25	8	-	0.1	5	КТ-23
2П 313 А	N-FET	15	15	6	-	0.12	7	КТ-13
КП 313 А	N-FET	15	15	6	-	0.075	7	КТ-13
2П 313 Б	N-FET	15	15	6	-	0.12	7	КТ-13
КП 313 Б	N-FET	15	15	6	-	0.075	7	КТ-13
2П 313 В	N-FET	15	15	6	-	0.12	7	КТ-13
КП 313 В	N-FET	15	15	6	-	0.075	7	КТ-13
АП 320 Б-2	N-FET	4	-	-	-	0.08	5	-
КП 322 А	N-FET	20	-	12	-	0.2	5	-
КП 323 А-2	N-FET	20	12	62	-	0.1	5	-
3П 324 А-2	N-FET	4	-	-	-	0.06	7	-
АП 325 А-2	N-FET	2	-	4	-	0.025	5	КТ-23
3П 325 А-2	N-FET	2.5	-	4	-	0.025	8	КТ-23
3П 326 А-2	N-FET	2.5	-	4	-	0.03	13	-
3П 326 Б-2	N-FET	3	-	4	-	0.05	13	-
КП 327 А	N-FET	18	30	2.7	-	0.2	9.5	КТ-29
КП 327 Б	N-FET	18	30	2.7	-	0.2	9.5	КТ-29
3П 328 А-2	N-FET	6	-	4	-	0.05	8	-
КП 333 А	N-FET	50	-	8	-	0.25	5	КТ-17
2П 333 А	N-FET	50	10	8	-	0.25	5	КТ-17
АП 339 А-2	N-FET	5.5	-	-	-	0.25	10	-
3П 339 А-2	N-FET	5.5	-	5	-	0.25	16	-
3П 339 А-5	N-FET	5.5	-	5	-	0.25	16	-
2П 341 А 5	N-FET	15	30	3	-	0.20	15	-
КП 341 А	N-FET	15	30	3	-	0.20	15	КТ-23
АП 343 А-2	N-FET	3.5	-	4	-	0.035	10	-
2П 350 А	N-FET	15	15	6	-	0.15	8	КТ-114
КП 350 А	N-FET	15	30	6	-	0.2	9	КТ-114
2П 350 Б	N-FET	15	30	6	-	0.2	9	КТ-114
КП 350 Б	N-FET	15	30	4	-	0.2	9	КТ-114
2П 350 В	N-FET	15	30	4	-	0.2	9	КТ-114
КП 350 В	N-FET	15	30	4	-	0.2	9	КТ-114
КП 364 А	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-26
КП 364 Б	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-26
КП 364 В	N-FET	25	20	4	-	0.2	3	КТ-26
КП 364 Г	N-FET	25	20	8	-	0.2	5	КТ-26
КП 364 Д	N-FET	25	20	8	-	0.2	2.6	КТ-26
КП 364 Е	N-FET	25	20	8	-	0.2	4	КТ-26
КП 364 Ж	N-FET	25	20	3	-	0.2	2	КТ-26
КП 364 И	N-FET	25	20	2	-	0.2	4	КТ-26
КП 365 А	N-FET	20	-	3	-	0.15	15	-
КП 501 А	N-FET	240	-	1	-	0.5	100	ТО-92
КП 501 Б	N-FET	200	-	1	-	0.5	100	-
2П 601 А	N-FET	20	-	9	-	2	63	КТ-312
КП 601 А	N-FET	20	-	9	-	2	63	КТ-312
КП 601 Б	N-FET	20	-	12	-	2	63	КТ-312
3П 602 А-2	N-FET	7	-	-	-	0.90	60	-
3П 602 А-2 Н	N-FET	7	-	-	-	0.90	60	-
3П 602 Б-2	N-FET	7	-	-	-	0.90	50	-
3П 602 Г-2	N-FET	7.5	-	-	-	1.8	120	-
3П 602 Д-2	N-FET	7.5	-	-	-	1.8	100	-
3П 603 А-2	N-FET	8	-	-	-	2.5	115	-
3П 603 Б-2	N-FET	8	-	-	-	2.5	130	-
3П 604 А-2	N-FET	8	-	-	-	0.90	30	-
3П 604 Б-2	N-FET	8	-	-	-	0.90	27	-
2П 701 А	N-FET	500	17	-	-	40	1500	КТ-48
КП 701 А (А702А)	N-FET	500	17	-	-	40	1500	КТ-48
КП 701 Б (А702Б)	N-FET	400	17	-	-	40	1500	КТ-48
2П 701 Б	N-FET	400	17	-	-	40	1500	КТ-48
КП 704 А	N-FET	200	10	1.5	0.35	75	1700	КТ-282
КП 704 Б	N-FET	200	10	1.5	0.5	75	1700	КТ-282
КП 707 А	N-FET	400	15	5	1	100	1500	-
КП 707 А1 (BUZ 90)	N-FET	400	15	5	-	50	1500	КТ-282
КП 707 А2	N-FET	400	15	-	-	50	1500	КТ-282
КП 707 Б	N-FET	600	10	5	2.5	100	1500	-
КП 707 Б1	N-FET	600	10	5	2	50	1500	КТ-282
КП 707 В	N-FET	800	7	5	3	100	1500	-
КП 707 В1	N-FET	800	7	5	3	50	1500	КТ-282
КП 707 В2 (BUZ 90)	N-FET	800	7	4.5	2.8	50	1500	КТ-282

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. сток-исток, В	Макс. ток сток-исток макс, А	Макс. напр. затвор-исток, В	Сопрот. канала в откр. сост., мОм	Макс. рассеив. мощность, Вт	Крутизна харак-ки, мА/В	Тип корпуса
КП 707 Г	N-FET	700	8	-	-	100	1500	-
КП 707 Г1	N-FET	700	8	-	2.5	50	1500	КТ-282
КП 707 Д	N-FET	500	12	-	-	50	1500	-
КП 707 Д1	N-FET	500	12	-	1.5	50	1500	КТ-282
КП 707 Е	N-FET	750	8	-	-	100	1500	-
КП 707 Е1	N-FET	750	8	-	5	50	1500	КТ-282
КП 723 А	N-FET	60	35	-	0.028	-	1000	ТО-220
КП 726 А	N-FET	600	4	-	2	-	1500	ТО-220
КП 767 Б (IRF 630)	N-FET	200	9	-	0.4	74	-	ТО-220 АВ
КП 767 В (IRF 640)	N-FET	200	18	-	0.18	125	-	ТО-220 АВ
КП 769 Б (IRF 530)	N-FET	100	14	-	0.16	88	-	-
КП 770 А (IRF 820)	N-FET	500	2.5	-	3	50	-	ТО-220 АВ
КП 770 В (IRF 822)	N-FET	500	2.5	-	4	50	-	ТО-220 АВ
КП 770 Д (IRF 830)	N-FET	500	4.5	-	1.5	74	-	ТО-220 АВ
КП 809 А	N-FET	400	25	5	0.3	100	1500	КТ-9
КП 809 А1	N-FET	400	25	-	0.3	100	1500	КТ-431
КП 809 А2	N-FET	400	25	-	0.3	100	1500	-
КП 809 Б	N-FET	500	20	-	0.6	100	1500	КТ-9
КП 809 Б1	N-FET	500	20	-	0.6	100	1500	КТ-431
КП 809 Б2	N-FET	500	20	-	0.6	100	1500	-
КП 809 Д	N-FET	800	10	-	1.8	50	1500	КТ-9
КП 810 А	N-FET	1300	7	-	0.2	50	-	КТ-432
КП 810 Б	N-FET	1000	7	-	0.2	50	-	КТ-432
КП 810 В	N-FET	1300	7	-	0.2	50	-	КТ-432
КП 812 А1	N-FET	60	50	2	0.028	125	15000	ТО-220 АВ
КП 812 Б1 (IRFZ 44)	N-FET	60	35	2	0.035	80	5500	ТО-220 АВ
КП 812 Б2	N-FET	60	35	2	0.035	80	5500	-
КП 812 В1 (IRFZ 34)	N-FET	60	30	2	0.05	70	9300	ТО-220 АВ
КП 813 А	N-FET	200	22	4	0.12	125	9000	ТО-3
КП 813 Б	N-FET	200	22	4	0.12	125	9000	ТО-3
КП 813 А1	N-FET	200	22	4	0.12	125	5500	-
КП 813 А2	N-FET	200	22	4	0.12	125	5500	-
КП 813 Б1	N-FET	200	22	4	0.18	125	5500	-
КП 813 Б2	N-FET	200	22	4	0.18	125	5500	-
2П 901 А	N-FET	70	4	-	-	20	100	КТ-42
КП 901 А	N-FET	70	4	-	-	20	100	КТ-42
2П 901 Б	N-FET	70	4	-	-	20	115	КТ-42
КП 901 Б	N-FET	70	4	-	-	20	115	КТ-42
2П 902 А	N-FET	50	0.2	-	-	3.5	18	КТ-42
КП 902 А	N-FET	50	0.2	-	-	3.5	17	КТ-42
2П 902 Б	N-FET	50	0.2	-	-	3.5	18	КТ-42
КП 902 Б	N-FET	50	0.2	-	-	3.5	17	КТ-42
КП 902 В	N-FET	50	0.2	-	-	3.5	17	КТ-42
2П 903 А	N-FET	20	0.7	-	-	6	112	КТ-42
КП 903 А	N-FET	20	0.7	12	-	6	112	КТ-42
2П 903 Б	N-FET	20	0.7	-	-	6	90	КТ-42
КП 903 Б	N-FET	20	0.7	6.5	-	-	90	КТ-42
2П 903 В	N-FET	20	0.7	-	-	6	100	КТ-42
КП 903 В	N-FET	20	0.7	10	-	-	100	КТ-42
2П 904 А ОСМ	N-FET	70	5	-	-	75	385	КТ-52
2П 904 А	N-FET	70	5	-	-	75	385	КТ-52
КП 904 А	N-FET	70	5	-	-	75	385	КТ-52
2П 904 Б	N-FET	70	5	-	-	75	385	КТ-52
КП 904 Б	N-FET	70	5	-	-	75	385	КТ-52
2П 905 А	N-FET	60	0.350	-	-	4	28	КТ-162
КП 905 А	N-FET	60	0.350	-	-	4	28	КТ-162
2П 905 Б	N-FET	60	0.350	-	-	4	28	КТ-162
КП 905 Б	N-FET	60	0.350	-	-	4	28	КТ-162
КП 905 В	N-FET	60	0.350	-	-	4	28	КТ-162
2П 907 А	N-FET	60	1.7	-	-	11.5	155	КТ-162
КП 907 А	N-FET	60	1.7	-	-	11.5	155	КТ-162
2П 907 Б	N-FET	60	1.3	-	-	11.5	155	КТ-162
КП 907 Б	N-FET	60	1.3	-	-	11.5	150	КТ-162
КП 907 В	N-FET	60	1.	-	-	11.5	95	КТ-162
2П 909 А	N-FET	50	6.5	-	-	60	350	-
2П 909 Б	N-FET	50	4	-	-	60	350	-
3П 910 А-2	N-FET	7	0.5	-	-	3	200	-
3П 910 Б-2	N-FET	7	0.5	-	-	3	200	-
3П 910 Б-2 ОС	N-FET	7	0.5	-	-	3	200	-
2П 911 А	N-FET	50	5	-	-	30	400	-
2П 911 Б	N-FET	50	4	-	-	30	400	-
2П 913 А	N-FET	50	14	-	-	100	1700	КТ-192
2П 913 Б	N-FET	50	10	-	-	100	1700	КТ-192
3П 915 А-2	N-FET	7	1.2	-	-	12	775	-
3П 915 Б-2	N-FET	7	1.2	-	-	12	650	-
КП 921 А	N-FET	40	10	-	0.13	15	800	КТ-282
2П 922 А	N-FET	100	10	-	-	75	1550	КТ-9
КП 922 А	N-FET	100	10	2	0.2	60	1550	КТ-9
КП 922 А1	N-FET	100	10	-	0.2	-	1550	-
2П 923 А	N-FET	50	12	-	-	100	1000	КТ-55
2П 923 Б	N-FET	50	8	-	-	100	700	КТ-55
КП 934 А	N-FET	450	15	-	0.1	40	10000	КТ-9
КП 936 В	N-FET	350	10	-	-	75	1750	КТ-282
КП 946 А	N-FET	400	15	-	0.1	-	-	-
КП 946 Б	N-FET	200	15	-	0.1	-	-	-
КП 948 А	N-FET	400	5	-	0.15	-	-	-
КП 948 Б	N-FET	300	5	-	0.15	-	-	-
КП 948 В	N-FET	370	5	-	0.15	-	-	-
КП 948 Г	N-FET	250	5	-	0.15	-	-	-
КП 953 А	N-FET	450	15	-	0.06	-	-	-
КП 953 Б	N-FET	300	15	-	-	0.06	-	-
КП 953 В	N-FET	450	15	-	-	0.06	-	-

## ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. сток-исток, В	Макс. ток сток-исток макс, А	Макс. напр. затвор-исток, В	Сопрот. канала в откр. сост., МОм	Макс. рассеив. мощность, Вт	Крутизна харак-ки, мА/В	Тип корпуса
КП 953 Д	N-FET	450	15	-	-	0.064	-	-
КП 954 А	N-FET	150	20	-	-	0.03	-	-
КП 954 Б	N-FET	100	20	-	-	0.03	-	-
КП 954 В	N-FET	60	20	-	-	0.025	-	-
КП 954 Г	N-FET	20	20	-	-	0.025	-	-
КП 955 А	N-FET	700	20	-	0.04	-	-	-
КП 955 Б	N-FET	450	20	-	0.003	-	-	-
КП 956 А	N-FET	350	2	-	0.6	-	-	-
КП 956 Б	N-FET	200	2	-	0.6	-	-	-
КП 957 А	N-FET	800	1.	-	0.8	-	-	КТ-272
КП 957 Б	N-FET	800	1.	-	0.8	-	-	КТ-272
КП 958 А	N-FET	150	30	-	0.02	-	-	-
КП 958 Б	N-FET	100	30	-	0.02	-	-	-
КП 958 В	N-FET	60	30	-	0.02	-	-	-
КП 958 Г	N-FET	20	20	-	0.02	-	-	-
КП 959 А	N-FET	300	0.2	-	57	-	40	КТ-272
КП 959 Б	N-FET	250	0.2	-	57	-	40	КТ-272
КП 959 В	N-FET	200	0.2	-	57	-	40	КТ-272
КП 960 А	P-FET	220	200	-	57	-	-	-
КП 960 Б	P-FET	200	200	-	57	-	-	-
КП 960 В	P-FET	120	200	-	57	-	-	-
КП 961 А	N-FET	120	5	-	0.16	-	-	-
КП 961 Б	N-FET	80	5	-	0.13	-	-	-
КП 961 В	N-FET	60	5	-	0.11	-	-	-
КП 961 Г	N-FET	40	5	-	0.10	-	-	-
КП 961 Д	N-FET	20	5	-	0.10	-	-	-
КП 961 Е	N-FET	10	5	-	0.8	-	-	-
КП 964 В	N-FET	60	20	-	0.025	-	-	-
КП 964 Г	N-FET	20	20	-	0.025	-	-	-
КП 965 Б	N-FET	100	20	-	0.6	-	-	-
КП 965 Г	N-FET	60	5	-	0.4	-	-	-
КП 965 Д	N-FET	20	5	-	0.4	-	-	-
КП 973 А	N-FET	700	30	-	0.03	-	-	-
КП 307 Ж	N-FET	25	25	7	-	0.25	9	-



## ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ CoolMOS

CoolMOS полевые транзисторы Infineon – это новое поколение высоковольтных силовых транзисторов со сверхнизким сопротивлением в открытом состоянии ( $R_{ds(on)}$ ), в 5-10 раз превосходящем параметры стандартных МОП-транзисторов. Транзисторы представлены тремя поколениями: S5 – транзисторы с малым  $R_{ds(on)}$ , C2 – поколение транзисторов с минимальным временем переключения, C3 – транзисторы с расширенной областью безопасной работы, позволяющие выдерживать импульсные токи с высокими амплитудами.

**Области применения:** импульсные источники питания в компьютерном оборудовании и бытовой технике, UPS, устройства коррекции коэффициента мощности, сварочное оборудование, системы электропитания.

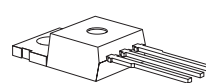
Наименование	Напряжение сток-исток, В	Сопротивление в откр. состоянии, Ом	Максимальный ток стока, А	Тип корпуса	Поколение
SPP02N60	600	3.0	2	TO-220	S5/C3
SPP03N60	600	1.4	3	TO-220	S5/C3
SPP04N60	600	0.95	4	TO-220	S5/C2/C3
SPP07N60	600	0.6	7	TO-220	S5/C2/C3
SPP11N60	600	0.38	11	TO-220	S5/C2/C3
SPP20N60	600	0.19	20	TO-220	S5/C2/C3
SPW11N60	600	0.38	11	TO-247	S5/C2/C3
SPW20N60	600	0.19	20	TO-247	S5/C2/C3
SPW47N60	600	0.07	47	TO-247	S5/C2/C3
SPP02N80	800	2.7	2	TO-220	C3
SPP04N80	800	1.3	4	TO-220	C3
SPP06N80	800	0.9	6	TO-220	C2/C3
SPP08N80	800	0.65	8	TO-220	C3
SPP11N80	800	0.45	11	TO-220	C3
SPP17N80	800	0.29	17	TO-220	C2/C3
SPW11N80	800	0.45	11	TO-247	C3
SPW17N80	800	0.29	17	TO-247	C2/C3

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

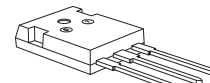
SP	P	11	N	60	C2
1	2	3	4	5	6

1. Полевой CoolMOS транзистор Infineon
2. Тип корпуса  
P - TO-220  
W - TO-247  
A - TO-220 (FullPAK)  
B - TO-220 SMD (D2PAK)  
D - TO-252 (D-PAK)  
I - I2PAK  
U - TO-251 (I-PAK)  
N - SOT-223
3. Максимальный пост. ток стока (прибл.), А
4. Тип транзистора  
N - n-канальный  
P - p-канальный
5. Максимальное напряжение сток-исток (x10), В
6. Поколение транзисторов  
S5 - 1-е поколение  
C2 - 2-е поколение  
C3 - 3-е поколение

## ТИПЫ КОРПУСОВ



TO-220



TO-247

## Приглашаем в офис продаж в С.-Петербурге

Адрес: С.-Петербург, ул. Зверинская, д. 44  
Тел./факс: (812) 232 8836; 232 2373; 232 5221  
E-mail: platan@mail.wplus.net  
Часы работы офиса: понедельник – пятница: 10.00 – 18.00